铝合金微弧氧化过程中电学参量的特性研究

吴汉华^{1 °} 龙北红^{2 °} 吕宪义² 汪剑波² 金曾孙²

1(吉林大学物理科学学院,长春 130023)

2(吉林大学超硬材料国家重点实验室,长春 130023)

3(吉林大学材料科学与工程学院,长春 130012)

(2004年7月2日收到;2004年8月4日收到修改稿)

利用自制的数据采集系统研究了恒定电压下铝合金微弧氧化过程中有关电学参量随时间的变化规律.结果表 明 通电回路中的阴极和阳极峰值电流随处理时间的变化明显分为 5 个阶段 ;陶瓷膜的动态正向电阻和电阻率随 处理时间分阶段变化 ,而动态的反向电阻和电阻率随时间的变化不大.在微弧氧化过程中 ,各时刻的动态正、反向 电阻值不同 ,一般情况下 动态正向电阻远大于反向电阻.对不同处理时间样品的扫描电子显微镜分析表明 ,陶瓷 膜呈多孔结构并随处理时间分阶段变化.

关键词:铝合金,微弧氧化,电学参量,陶瓷膜 PACC:6150J,6160,8245

1.引 言

微弧氧化是一种利用阀金属(Al, Ti, Mg, Hf 等 或其合金在特定的电解液中作为阳极 在不对称 的交流高电压作用下,阳极表面发生大量的微小火 花放电。在热化学、电化学和等离子体化学的共同作 用下生长氧化陶瓷膜的新技术[1-5],它所制备的陶 瓷膜具有优异的物理化学性能^[6-8],因而引起国内 外材料研究工作者的高度关注,在微弧氧化过程中, 一种是保持电流密度不变,采用不同的处理时间;另 一种是保持处理时间不变,采用不同的电流密度,采 用上述方式所制备的陶瓷膜成分、结构及其特性在 许多的文献中都先后进行过报道^{9-12]}但由于微弧 氧化是一个多种因素控制的复杂过程 氧化陶瓷膜 的品质因而受多种技术参数的影响 例如 电解液的 成分、浓度和温度,阳极所采用的材料,电极所加的 电压、电流大小 处理时间的长短等都与氧化陶瓷膜 的品质有很重要的关系,只有合理选择微弧氧化过 程中的各种参数,才能获得较高品质的氧化陶瓷膜. 本文的主要目的是在保持交流电压脉冲幅度不变的 条件下、研究微弧氧化过程中阴极和阳极峰值电流, 有效工作电流 陶瓷膜的动态电阻和电阻率等随处

理时间的变化规律 ,并对不同处理时间段所制备的 陶瓷膜的微观结构进行分析.

2. 实验方法

先将铝合金(LY12)加工成 \$25 mm × 2 mm 的圆 饼形 然后进行抛光、除油、丙酮超声、酒精和去离子 水清洗、烘干处理.试样作阳极浸在4g/LNaOH和8 g/L Na, SiO, 的电解液中,不锈钢容器作阴极,电解液 温度保持在 19—40 ℃之间,电压和电流随时间的变 化关系由自制的数据采集系统通过串行通讯口由微 机自动进行记录,样品的电源开关也由微机通过单 片机 AT89C52 控制,以便在微弧氧化开始时就能将 工作电压加到所需的值.保持阳极峰值电压 V_{ap} = 413 V , 阴极峰值电压 V , 忠 = 143 V , 制备处理时间 t = 120 53 35, 20, 10 和 1 min 的样品共 6 块, 并记录了 $t = 120 \min$ 的样品在微弧氧化过程中的阴极峰值电 流 I_m、阳极峰值电流 I_m和有效工作电流随处理时 间的变化.将这些样品沿轴线方向切开,并在600# 沙纸上磨平、抛光 由带 CCD 头的 XIZ-6A 型光学显 微镜确定氧化陶瓷膜的厚度,用 Hitachi X-650 型扫 描电子显微镜 SEM 观察氧化陶瓷膜的表面形貌.

3. 实验结果及分析

3.1. 电流的变化规律

根据文献 7 可知 ,微弧氧化过程中电流变化曲 线一般是指样品的有效工作电流随时间的变化.我 们通过自制的数据采集系统 ,记录了样品在 120 min 氧化过程中 ,有效工作电流及 I_{ep} , I_{ap} 随处理时间的 变化(图 1).从图 1 可以看出 ,这三条电流曲线明显 分为 5 个不同阶段 ,它们所对应的时间段分别为 0—1 ,1—35 ,35—53 ,53—113 和 113—120 min.从图 1 还可以看出 , I_{ep} , I_{ap} 和样品的有效工作电流在 1 ,3 , 4 ,5 这 4 个阶段的变化趋势基本相同 ,但它们在第 2 阶段的变化有较大的差异.在第 2 阶段 I_{ap} 随着 t 的 增加 ,先呈现缓慢下降的趋势 ,当达到最小值后又开 始缓慢上升 ; I_{ep} 在这一阶段的变化不大.



图 1 电流随处理时间的变化 (a) 阳极峰值电流 (b) 阴极峰值 电流 (c) 有效工作电流

3.2. 陶瓷膜的微观结构

我们按图 1 中电流随处理时间 t 的 5 个变化过 程 ,制备了 t = 1 ,10 ,20 ,35 ,53 和 120 min 的样品共 6 块 .用 t = 1 ,10—35 和 53 min 的样品分别研究图 1 中第 1、第 2 和第 3 阶段的特性.由于第 5 阶段时间 很短 ,我们用 t = 120 min 的样品研究第 4 阶段的特 性.这些样品的 SEM 照片如图 2 所示.

从图 (x a)可以看出, *t* = 1 min 的样品表面已生成了一层薄膜, 它主要由 Al₂O₃ 组成^[13].样品表面能

见到大量直径不到 1 µm 的微孔和大小不等的不连 续熔融体 这些现象是样品表面产生大量的微小火 花放电所形成的[7].由于样品表面这层多孔氧化铝 薄膜的形成,致使通电回路的电阻迅速增大,从而 导致图 1 中的 I m和 I m在第 1 阶段迅速下降. 从图 2 (b)(c)和(d)可以看出,t=10,20和35min的样品 表面布满了尺寸在 2-3 µm 之间的微孔,其尺寸和 分布密度差异不大;从图 2(h)看出,这些微孔是微 弧放电时所形成的放电通道. Gordienko 等⁸³认为,单 一微弧的电流为 10⁻³—10⁻² A,放电持续时间约 10-20 µs 样品的电流大小由单个弧点的面积和弧 点的多少决定,在图1中的第2阶段,由于样品在单 位时间内和表面单位面积上所发生的微弧放电数量 的变化均不大 且弧点大小基本相同 因而在这一阶 段电流变化不大,从图 2(e)可以看出,样品表面的 放电通道尺寸比图 2(b)-(d)的大,其中某些部位 经过多次放电后 使得原来较小的通道彼此相连而 形成较大的放电通道 数量也明显增多 因而导致图 1 中的 I 和 I 在第 3 阶段又开始增加. 随着处理时 间的进一步增加,样品表面的某些位置多发生连续 击穿放电现象 放电的弧光斑点变得更大 但总的数 量在减少.由图 χ_{f})可见 样品表面能见到的放电通 道数明显比前一阶段少;由图 2(g)可见,氧化膜厚 度约为 50 µm, 它分为表面疏松层和内部致密层,其 中致密层厚度约为 30 µm.随着处理时间的增加,氧 化膜逐渐变厚 致使部分放电通道相继被喷出来的 熔融氧化铝在遇到电解液冷却、凝固后所堵塞 如图 χ i)所示.这导致图 1 中的第 4 阶段 I_{co} 和 I_{ao} 随 t 的 增加反而下降.

3.3. 陶瓷膜动态电阻的变化规律

根据阴极和阳极峰值电流随 *t* 的变化数据,采 用 16 点求和平均合并为一点的方法得到 I_{ep} 和 I_{ap} , 利用动态正向电阻 $R_{dd} = \frac{V_{ap}}{I_{ap}}$,动态反向电阻 $R_{du} = \frac{V_{ep}}{I_{ep}}$ 的关系 ,分别得到微弧氧化过程中陶瓷膜的 R_{dd} 和 R_{du} 随 *t* 的变化规律(图 3).从图 3 可以看出 , R_{dd} 随 *t* 的变化可分成 4 个过程 10—10 min 为电阻的快速减 小过程 40—115 min 为电阻的平缓变化过程 ,115— 120 min 为电阻的再次快速增大过程 .而 R_{du} 在 0— 120 min 之间的变化幅度只有 7 Ω(139—146 Ω).按



图 2 不同处理时间铝合金氧化陶瓷膜的表面和截面形貌 (a)(b)(c)(d)(e)和(f),分别为 *t* = 1,10,20,35,53 和 120 min 样品的表面 SEM 照片(g)*t* = 120 min 样品的截面 SEM(∐ 为疏松层, Ⅲ 为致密层, Ⅲ 为基体)(b)*t* = 35 min 样品放大 5000 倍的表面 SEM 照片(i)*t* = 120 min 样品放大 10000 倍的 SEM 照片

Yerokhin 等⁷¹的观点,0—10 min 之间电阻的快速增 大是由于铝合金表面快速形成绝缘钝化膜所致.在 强电场的作用下,这层膜的某些薄弱部位发生电击 穿导致在阳极表面形成多孔的氧化膜,从而出现 10—40 min 之间电阻的快速减小过程.虽然氧化膜 的厚度随 t 的增加而增加,但由于它的多孔性导致 其在电解液中的等效电阻随 t 的变化较小 ,从而出 现 40—115 min 之间电阻的平缓变化过程.随着 t 的 增加 ,部分微弧放电通道相继被阻塞(如图 χ i)所 示),使致密的氧化膜层再次形成(如图 χ g)所示), 导致通电回路的导电性能下降 ,从而出现了 115— 120 min 之间电阻的再次快速增大过程.从图 3 还可 以看出,氧化过程中不同处理时间的动态正、反向电阻值不同,一般情况下 R_{dd}远大于 R_{du}.这一现象正好表明:阀金属在微弧氧化过程中,在金属-氧化物-电解液体系中具有电解阀门的作用^[14].



图 3 陶瓷膜动态电阻随处理时间的变化 (a)动态正向电阻, (b)动态反向电阻

3.4. 陶瓷膜动态电阻率的变化规律

陶瓷膜的电阻率可表示为

$$\rho = R \frac{S}{l} , \qquad (1)$$

式中 *S* 为样品表面积 ,*l* 为陶瓷膜的厚度.表 1 给出 了不同处理时间的氧化陶瓷膜厚度.

表 1 不同处理时间的陶瓷膜厚度

t/\min	1	10	20	35	53	63	90	120	
$l/\mu m$	1	4	10	20	38	45	50	55	

根据表 1 我们从图 3 中查出对应处理时间 t 陶 瓷膜的 R_{dd} 和 R_{du} 利用(1)式即可以求出动态正向电 阻率 ρ_{dd} 和动态反向电阻率 ρ_{du} .图 4 给出了陶瓷膜 形成过程中电阻率随 t 的变化规律.从图 4 可以看 出 ρ_{du} 在前 20 min 内 随 t 缓慢减小,以后基本不随 t 变化 $m \rho_{dd}$ 则随 t 的变化比较大.在 0—10 min 之 间 ρ_{dd} 随 t 的增加迅速变大 ra 10—40 min 之间 ρ_{dd} 随 t 的增加迅速变大 ra 10—40 min 之间 ρ_{dd} 随 t 的增加迅速变小 ra 40—90 min 之间 ρ_{dd} 随 t 的 变化不大 rac 90—120 min 之间 ρ_{dd} 又随 t 的增加 缓慢增加.这是由于铝合金在电解液中通电后,其表 面迅速形成绝缘钝化膜,导致 0—10 min 之间的 ρ_{dd} 迅速增加.由于形成的这层膜具有一定的临界电击 穿电位^[15],在高电压产生的强电场作用下(约 10⁶ V/m 量级),膜层中的相对薄弱微区被同时击穿形成 放电通道,这些通道被电子雪崩产生的大电流加热 到约 10⁴ K^[5],电解液中的阴离子被注入到导电通道 中 同时由于高温的作用 熔融的铝及其合金从基体 上脱离后进入导电通道 由于这些过程的作用 导致 在通道中形成等离子体柱 随后在通道中发生等离 子体化学反应,导致通道中的压力增加,为了保持平 衡,等离子体柱的体积则相应变大,与此同时,由于 电场的作用带相反电荷的离子(阳离子)也出现在导 电通道中 由于静电力的作用这些阳离子从通道中 被注入到电解液中,放电通道被电解液冷却,反应中 的产物(如 Al₂O₃ 等)被沉积在放电通道的内壁和通 道口附近的样品表面上,这样导致多孔的氧化膜形 成,由于这些微孔中渗透着电解液 因而形成导电通 道,从而使 pad 在 10-40 min 之间迅速减少. 随着处 理时间的增加,由于部分放电通道被相继堵塞(如图 众·i)所示),导致氧化膜的致密程度有所增加,从而 使 Quit在 90—120 min 之间又缓慢增加.



图 4 陶瓷膜动态电阻率随处理时间的变化

4.结 论

本文利用自制的数据采集系统研究了恒定电压 下铝合金微弧氧化过程中相关电学参量随时间的变 化规律 通过实验可得到下述结论.

1) 阴极和阳极峰值电流及有效工作电流随处理 时间的变化都分为 5 个阶段,但它们在第 2 阶段的 变化规律有明显的不同。

2) 成膜过程中陶瓷膜的动态正向电阻和电阻率 也分阶段变化,但动态反向电阻和电阻率随处理时 间的变化不大.陶瓷膜的动态正、反向电阻不同,一 般情况下动态正向电阻远大于动态反向电阻.

- [1] Gruss L L , McNeil W 1963 Electrochem. Technol. 1 283
- [2] Nikolaev A V, Markov G A, Peshchevitskij B I 1977 Ser. Khim. Nauk. 12 32 (in Russian)
- [3] Brown S D, Wirtz G P 1986 J. Electrochem. Soc. 133 92
- [4] Kurze P, Schreckenbach J et al 1986 Metal-loberflache. 12 539
- [5] Albella J M , Montero I , Martinezduart J M et al 1991 J. Mater. Sci. 26 3422
- [6] Belevantsev V I, Terleeva O P, Markov G A et al 1998 Protect. Met. 34 416
- Yerokhin A L , Nie X , Leyland A et al 1999 Surf. Coat. Technol.
 122 73
- [8] Gordienko S V, Khrisanfova O A, Zavidnaya A G et al 2000 Surf. Coat. Technol. 123 24

- [9] Chigrinova N M, Chigrinov V E, Kukharev A A 2000 Protect. Met. 36 269
- [10] Twite R L , Bierwagen G P 1998 Prog. Org. Coat. 33 91
- [11] Shimizu K, Brown G M, Kobayashi K et al 1998 Corros. Sci. 40 1049
- [12] Yerokhin A L , Lyubimov V V , Ashitkov R V 1998 Ceram. Inter. 24 1
- [13] Wu H H, Jin Z S, Long B Y et al 2003 Chin. Phys. Lett. 20 1815
- [14] Guntershulze A, Betz H 1938 Electrolytic Capacitors (Moscow: Obornizidat) p238
- [15] Ikonopisov S , Andreeva L 1973 J. Electrochem. Soc. 120 1361

Study on the electrical parameter variation during microarc oxidation of aluminium alloys

Wu Han-Hua¹⁽²⁾ Long Bei-Hong²⁽³⁾ Lü Xian-Yi²⁾ Wang Jian-Bo²⁾ Jin Zeng-Sun²⁾

¹) College of Physics Science , Jilin University , Changchun 130023 , China)

 2 (State Key Laboratory for Superhard Materials , Jilin University , Changchun 130023 , China)

³ College of Material Science and Engineering , Jilin University , Changchun 130012 , China)

(Received 2 July 2004; revised manuscript received 4 August 2004)

Abstract

The variation of electrical parameters during microarc oxidation(MAO) of aluminium alloys at constant voltage has been studied by means of a laboratory-made data acquisition system. Experimental results show that the variations of the cathodic and anodic current amplitude and effective working current in an electrical loop with the duration of treatment show obviously five stages, and the variations of dynamic positive resistance and the rate of change of resistance in coatings also show different stages, while the variations of dynamic negative resistance and the rate of change of resistance with oxidation time are not evident. During the MAO process, the dynamic positive resistance is always not equal to the negative resistance, and the former is generally greater than the latter in general. Scanning electron microscopy analysis shows that the surface morphology of MAO coatings is macro-porous and its variations with treatment time are in steps.

Keywords : aluminium alloy , microarc oxidation , electrical parameter , ceramic coating PACC : 6150J , 6160 , 8245